1/5/3 (Item 3 from file: 351)
DIALOG(R)File 351:Derwent WPI

(c) 2006 The Thomson Corporation. All rts. reserv.

0010420453

WPI ACC NO: 2001-018893/ XRAM Acc No: C2001-005466

Catalyst for cross coupling reaction for production of substituted-styrene or -biaryl derivatives, contains Group VIII metal compound and/or Groups IIB and IIIB organometallic compound having no metal hydride structure.

Patent Assignee: TOSOH CORP (TOYJ)

Inventor: EGUCHI H; HARA T

Patent Family (1 patents, 1 countries)

Patent Application

Number Kind Date Number Kind Date Update

JP 2000229243 A 20000822 JP 199931106 A 19990209 200103 B

Priority Applications (no., kind, date): JP 199931106 A 19990209

Patent Details

Number Kind Lan Pg Dwg Filing Notes

JP 2000229243 A JA 11 0

Alerting Abstract JP A

NOVELTY - A catalyst for a cross coupling reaction contains at least one selected from Group VIII metal compound, and Groups IIB and IIIB organometallic compound having no metal hydride structure.

USE - The catalyst is used for a cross coupling reaction. The method produces the substituted styrene derivative, or the substituted biaryl derivative using the catalyst. The catalyst and the substituted styrene derivative, or the substituted biaryl derivative are used for producing electronic materials, including a liquid crystal, intermediates for medical supplies, agricultural chemicals, or a monomer for a functional macromolecule.

ADVANTAGE - The catalyst exerts the vinyl-aryl cross coupling reaction and the aryl-aryl cross coupling reaction in high efficiency and high selectivity. A homocoupling product, and a polymer, side products, are reduced. A large amount of the catalyst is available at lower costs. The vinyl-aryl cross coupling reaction in a tetrahydrofuran solvent is smoothly accelerated.

Title Terms/Index Terms/Additional Words: CATALYST; CROSS; COUPLE; REACT; PRODUCE; SUBSTITUTE; STYRENE; DERIVATIVE; CONTAIN; GROUP; METAL; COMPOUND; NO; HYDRIDE; STRUCTURE

Class Codes

International Classification (Main): B01J-031/28

(Additional/Secondary): B01J-031/24, B01J-031/30, C07B-061/00, C07C-001/32

, C07C-015/44, C07C-017/263, C07C-025/28

File Segment: CPI DWPI Class: A41; E14

Manual Codes (CPI/A-M): A01-D03; E05-A; E05-B; E05-C; E05-E; E05-F01;

E10-H03C1; E10-H03D; E10-J02B3

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2000-229243 (P2000-229243A)

(43)公開日 平成12年8月22日(2000.8.22)

(51) Int.Cl.'		識別記号		FΙ			テ	-マコード(参考)
	31/28			B 0	LJ 31/28		Z	4G069
	31/24				.31/24		Z	4H006
	31/30				31/30		Z	4H039
C-0 7 C	1/32			C 0 '	7 C 1/32			. •
	15/44				15/44			
			審査請求	未請求	請求項の数8	OL	(全 11 頁)	最終頁に続く

(21)出願番号 特願平11-31106

平成11年2月9日(1999.2.9)

(71)出願人 000003300

東ソー株式会社

山口県新南陽市開成町4560番地

(72) 発明者 原 大治

山口県新南陽市土井2丁目15番4-207

(72)発明者 江口 久雄

山口県新南陽市中畷町1番27

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 クロスカップリング反応用触媒、並びにそれを用いた置換スチレン誘導体又は置換ピアリール誘導体の製造方法

(57)【要約】

(22)出願日

【課題】 触媒効率が高く、目的物を溶媒種類等の反応 条件によらず高収率かつ高選択率で得ることを可能と し、安価な成分によって構成されるクロスカップリング 反応用触媒を提供すること、及びこれを用い置換スチレ ン誘導体や置換ビアリール誘導体等の有機化合物を効率 的に製造する方法を提供する。

【解決手段】 周期律表第四周期VIII族金属化合物と、金属ヒドリド構造をもたない周期律表IIB族及びIIIB族有機金属化合物からなる群より選ばれた少なくとも一種を含有するクロスカップリング反応用触媒を用い、置換スチレン誘導体や置換ビアリール誘導体を製造する。

7 1. 3 % の 収率 で 回収 された。 結果 を 表 1 に あわせ て 示す。

【0035】比較例2

実施例1のクロスカップリング反応において、触媒成分として、塩化第二鉄(III)1.22g(7.52mmol)にトリエチルアルミニウムの0.94mol/しのヘキサン溶液80.0ml(75.20mmol)を混合し、室温にて1時間攪拌の後、ヘキサンでトリエチルアルミウムが検出されなくなるまで洗浄した鉄触媒系を用いたこと以外は、実施例1と同様にpークロロスチレンの合成を行った。結果は、pークロロスチレンンのが、pークロロスチレンユニット換算で77.5%の収率で回収され、トリエチルアルミニウムの共存が必須であることが示された。結果を表1にあわせて示す。

[0036] 実施例3

実施例1のクロスカップリング反応において、触媒成分として、塩化第二鉄(III)及びトリエチルアルミウムに変えて、二塩化[1,3-ビス(ジフェニルホスフィノ)プロパン]鉄(II)4.05g(7.52mm 2001)にトリイソブチルアルミニウムの0.96mol/Lのヘキサン溶液39.2ml(37.60mmol)を混合した触媒系を用いたこと以外は、実施例1と同様にp-クロロスチレンの合成を行った。結果は、p-クロロスチレン収率59.0%であった。結果を表1にあわせて示す。

【0037】比較例3

実施例1のクロスカップリング反応において、触媒成分として、塩化第二鉄(III)及びトリエチルアルミウムに変えて、二塩化[1,3-ビス(ジフェニルホスフィノ)プロパン]鉄(II)4.05g(7.52mmol)のみを用いたこと以外は、実施例1と同様にpークロロスチレンの合成を行った。結果は、pークロロスチレン収率11.6%であった。更にポリ(pークロロスチレン)が、pークロロスチレンユニット換算で69.6%の収率で回収され、トリイソブチルアルミニウムの共存が必須であることが示された。結果を表1にあわせて示す。

【0038】実施例4

実施例1のクロスカップリング反応において、触媒成分として、塩化第二鉄(III)及びトリエチルアルミウムに変えて、二塩化[1,3-ビス(ジフェニルホスフィノ)エタン]コバルト(II)3.97g(7.52mmol)にトリエチルアルミニウムの0.94mol/Lのヘキサン溶液40.0ml(37.60mmol)を混合した触媒系を用いたこと以外は、実施例1と同様にp-クロロスチレンの合成を行った。結果は、p-クロロスチレン収率64.2%であった。結果を表1にあわせて示す。

[0039]比較例4

18

実施例 1 のクロスカップリング反応において、触媒成分として、塩化第二鉄(1 1 1) 及びトリエチルアルミウムに変えて、二塩化 [1 , 3 - ピス(ジフェニルホスフィノ)エタン [コバルト([1] [1]

【0040】実施例5

実施例1のクロスカップリング反応において、触媒成分として、塩化第二鉄(III)及びトリエチルアルミウムに変えて、二塩化[1,3-ビス(ジフェニルホスフィノ)プロパン]ニッケル(II)4.08g(7.52mmol)にトリイソブチルアルミニウムの0.96mol/Lのヘキサン溶液39.2ml(37.60mmol)を混合した触媒系を用いたこと以外は、実施例1と同様にp-クロロスチレンの合成を行った。結果は、p-クロロスチレン収率79.9%であった。結果を表1にあわせて示す。

【0041】実施例6

【0042】比較例5

実施例1の有機マグネシウム化合物の合成において、パラブロモクロロベンゼンに変えてパラジクロロベンゼン を用い、更にクロスカップリング反応において、触媒成分として、塩化第二鉄(111)及びトリエチルアルミウムに変えて、二塩化[1,3- ピス(ジフェニルホスフィノ)プロパン]ニッケル(11)4.08g(7.52mmol)のみを用いたこと以外は、実施例1と同様にp-クロロスチレンの合成を行った。結果は、p-クロロスチレン収率9.6%であり、未反応p-クロロスチレン収率78.8%で回収した。

【0043】このように、テトラヒドロフラン単一溶媒及び二塩化 [1,3-ビス(ジフェニルホスフィノ)プロパン]ニッケル(11)触媒を用いたクロスカップリング反応は、進行し難いことが確認された。結果を表1にあわせて示す。

[0044]

【発明の効果】本発明の第一の効果は、ピニルーアリー ルクロスカップリング反応及びアリールアリールクロス カップリング反応を高効率かつ高選択的に行うことができることにあり、副生成物であるホモカップリング物や 重合体を低減できることにある。よって、機能性高分子 用モノマー、液晶等の電子材料、医農薬中間体を製造す るに極めて有利である。

【0045】第二の効果は、触媒系が従来技術のそれよりも、安価にかつ大量に調達でき、経済的に極めて有利

なことである。殊に、ハロゲン化鉄とアルキルアルミニウムとから成る触媒系は、工業的に極めて有利である。 【0046】第三の効果は、従来困難であったテトラヒドロフラン単一溶媒中でのピニルーアリールクロスカップリング反応を円滑に進行させることが可能なことであり、機能性高分子用モノマー製造に殊に有効なことにあ

フロントページの続き

FI 7-73-ド(参考) C 0 7 C 17/263 25/28 C 0 7 B 61/00 3 0 0

F 夕一ム(参考) 4G069 AA06 AA09 BA21C BA27A BA27B BB08A BB08B BB09A BB10A BB12A BB14A BC15A BC16A BC16A BC16B BC17A BC34A BC35A BC36A BC37A BC65A BC66A BC66B BC67A BC67B BC68A BC68B BD12B BE01A BE01B BE08A BE11A BE14C BE26A BE26C BE27A BE27B BE37A BE45A BE46B CB01 CB25 DA02 FC04

4H006 AA02 AC22 BA05 BA07 BA09 BA19 BA20 BA21 BA32 BA34 BA35 BA36 BA37 BA44 BA45 BA47 4H039 CA21 CA41 CD20 CD90

•

【特許請求の範囲】

- 4%

と、金属ヒドリド構造をもたない周期律表 I I B族及び I I I B族有機金属化合物からなる群より選ばれた少なくとも一種を含有するクロスカップリング反応用触媒。 【請求項2】 周期律表第四周期VI I I 族金属化合物、金属ヒドリド構造をもたない周期律表 I I B族及び I I I B族有機金属化合物からなる群より選ばれた少なくとも一種、並びに電子供与性化合物を含有することを特徴とする請求項1に記載のクロスカップリング反応用触媒。

【請求項1】 周期律表第四周期VIII族金属化合物

【請求項3】 周期律表第四周期VIII族金属化合物が、ハロゲン化鉄化合物又はハロゲン化コバルト化合物であることを特徴とする請求項1又は請求項2に記載のクロスカップリング反応用触媒。

【請求項4】 金属ヒドリド構造をもたない周期律表 I I B族及び I I I B族有機金属化合物が、有機アルミニウム化合物又は有機亜鉛化合物であることを特徴とする請求項 1 乃至請求項 3 のいずれかに記載のクロスカップリング反応用触媒。

【請求項5】 電子供与性化合物が、アミン化合物及び /又はホスフィン化合物であることを特徴とする請求項 2乃至請求項4のいずれかに記載のクロスカップリング 反応用触媒。

【請求項6】 下記一般式(8)

ArLi (8)

(式中、Arは、アリール基及び置換アリール基を示す。)で示されるアリールリチウム化合物又は下記一般式(9)

ArMX (9)

(式中、Arは、アリール基及び置換アリール基を示し、Mは、Mg、Zn、B、Al、Si又はSnを示し、Xは、ハロゲン又はアルコキシ基を示す。)で示される有機金属化合物と、下記一般式(10)

RX (10)

(式中、Rはビニル基、アリール基又は置換アリール基を示し、Xはハロゲンを示す。) で示されるハロゲン化 炭化水素を、請求項1乃至請求項5のいずれかに記載のクロスカップリング反応用触媒の存在下反応させることを特徴とする置換スチレン誘導体又は置換ビアリール誘 40 導体の製造方法。

【請求項7】 置換フェニルブロミドと塩化ビニルを反応させることを特徴とする請求項6に記載の製造方法。

【請求項8】 単一のエーテル溶媒中でクロスカップリング反応を行なうことを特徴とする請求項6又は請求項7に記載の製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、液晶等の電子材料、医農薬中間体、機能性高分子用モノマー等を製造を 50

するため有機合成上重要なクロスカップリング反応に対し、極めて有効な触媒及びそれを用いた有機化合物の製造方法に関するものである。

[0002]

【従来の技術】クロスカップリング反応用触媒として は、これまでに種々のものが知られている。殊に、有機 マグネシウム化合物とハロゲン化有機化合物とを触媒存 在下、クロスカップリング反応を行う方法については、 数多くの提案があり、中でも近年、ホスフィン配位子を 有するNi種やPd種を用いたクロスカップリング反応 の提案が数多くなされている。例えば、(1)Bul l. Chem. Soc. Jpn., <u>49</u>, 1958 (1 976) Organic Synthesis 5 8, 127には、種々のホスフィン配位子を有するニッ ケル錯体を用いたアルキルマグネシウム化合物、アルケ ニルマグネシウム化合物、アリールマグネシウム化合物 とアルキルハライド、アルケニルハライド、アリールハ ライドとのカップリング反応について記載されており、 この応用技術として、(2)特公昭57-2692号公 報及び特公昭62-1927号公報において、触媒とし てニッケル・ホスフィン錯体を用いたアルキルベンゼン 誘導体やスチレン誘導体の製造方法が開示されている。 しかしながら、特公昭62-1927号公報にも明確に 記載されている様に、THF単独溶媒系では、収率が低 下するか、クロスカップリング反応が全く進行しない場 合があったり、使用溶媒、触媒種が極めて限定される等 の問題点を有していた。

【0003】また、有機マグネシウム化合物以外にも、有機亜鉛化合物や有機ホウ素化合物と有機ハライド化合物とのクロスカップリング反応に関する研究及び応用技術が提案されている。例えば、(3)J.Org.Chem.,42,1821(1977)には、Pd又はNi触媒下に、アリール亜鉛化合物とアリールハライドとのクロスカップリング反応させる方法が開示されており、(4)Synth.Commun.,11,513(1981)には、Pd触媒によるアリールホウ酸化合物とアリールハライドとのクロスカップリング反応が提案されている。

[0004] しかしながら、これら方法は、活性種としてPdを用いる為、経済性の面で問題点を有していた。 [0005]

【発明が解決しようとする課題】上述した従来の技術は、現在でも、液晶等の電子材料、医農薬中間体、機能性高分子用モノマー等の製造に応用されているものの、更に効果的で、汎用性があり、経済的なクロスカップリング反応用触媒及びそれを用いたクロスカップリング反応が望まれていた。

[0006] 本発明は上記の課題に鑑みてなされたものであり、その目的は、本発明は、触媒効率が高く、目的物を溶媒種類等の反応条件によらず高収率かつ高選択率

10

3

で得ることを可能とし、安価な成分によって構成される クロスカップリング反応用触媒を提供すること、及びこれを用い個換スチレン誘導体や個換ピアリール誘導体等 の有機化合物を効率的に製造する方法を提供することで ある。

[0007]

【課題を解決するための手段】本発明者らは、周期律表第四周期VIII属金属化合物に、金属ヒドリド構造をもたない周期律表IIB族及びIIIB族有機金属化合物の群より選ばれた少なくとも一種を含有する触媒が、上記したクロスカップリング反応に極めて有効であることを見出し、本発明を完成させるに至った。

【0008】すなわち本発明は、周期律表第四周期V1 II族金属化合物と、金属ヒドリド構造をもたない周期 律表IIB及びIIIB族有機金属化合物からなる群よ り選ばれた少なくとも一種を含有するクロスカップリン グ反応用触媒、及びそれを用いた置換スチレン誘導体又 は置換ビアリール誘導体の製造方法である。

[0009]以下の本発明を更に詳細に説明する。

【0010】本発明において使用する周期律表第四周期 VIII族金属化合物としては、Fe(0)、Fe(II)、Fe(III)、Co(0)、Co(I)、Co(II) 、Co(II) 、Co(III) 、Ni(0) 、Ni(II) を金属種として有する無機化合物、有機化合物及び有機 金属錯体を使用することができる。

【0012】また、一般式(1)

 $L_n F e X_m$ (1)

(式中、しは、懺換ホスフィン配位子、カルボニル配位子又はアミン配位子を示し、各々同一であっても異なっても良く、懺換ホスフィン配位子の場合、架橋されていても良い。nは配位数を示し0~6の整数である。Feは、零価、一価、二価又は三価である。Xは、ハロゲン原子、水素原子又は炭素数1~20の炭化水素基であり、各々同一であっても異なっても良い。mはFeの価数に相当する数を示す。)で示される有機鉄錯体、例え

ば、ピス (シクロオクタテトラエン) 鉄(0)、ピス [1, 2-ピス(ジフェニルホスフィノ) エタン] エチ レン鉄(0)、テトラカルボニル(トリフェニルホスフ ィン) 鉄(0)、トリカルボニルビス(トリフェニルホ スフィン) 鉄(0)、二塩化ビス(トリフェニルホスフ ィン)鉄(II)、二臭化ビス(トリフェニルホスフィ ン) 鉄(II)、二沃化ピス(トリフェニルホスフィ ン) 鉄(II)、二塩化[1, 2-ピス(ジフェニルホ スフィノ) エタン] 鉄(ΙΙ)、二臭化 [1, 2-ビス (ジフェニルホスフィノ) エタン] 鉄(11)、二沃化 [1, 2-ピス (ジフェニルホスフィノ) エタン] 鉄 (11)、二塩化[1,3-ビス(ジフェニルホスフィ ノ) プロパン] 鉄(II)、二臭化[1,3-ビス(ジ フェニルホスフィノ)プロパン] 鉄(II)、二沃化 [1, 3-ビス(ジフェニルホスフィノ)プロパン] 鉄 (11)、二塩化ビス (トリーt-プチルホスフィン) 鉄(II)、二臭化ピス(トリーtーブチルホスフィ ン) 鉄(II)、二沃化ビス(トリーtープチルホスフ ィン) 鉄(I I)、二塩化[1, 2-ビス(ジーtーブ チルホスフィノ) エタン] 鉄 (II)、二臭化 [1, 2 - ピス (ジ- t - ブチルホスフィノ) エタン] 鉄 (I I)、二沃化[1, 2-ビス(ジーt-ブチルホスフィ ノ) エタン] 鉄 (I I) 、二塩化 [1, 3 - ピス (ジー t-ブチルホスフィノ)プロパン] 鉄(II)、二臭化 [1, 3-ビス (ジーtーブチルホスフィノ) プロパ ン] 鉄 (II) 、二沃化 [1, 3-ビス (ジーtープチ [1, 2-ビス(ジフェニルホスフィノ)エタン] 鉄 (11)、ジヒドリドビス[1,3-ビス(ジフェニル ホスフィノ) プロパン] 鉄(II)、ジヒドリドビス [1, 2-ビス (ジーtーブチルホスフィノ) エタン] 鉄 (II)、ジヒドリドピス [1, 3-ピス (ジーtー ブチルホスフィノ) プロパン] 鉄(11)、塩化(シク ロペンタジエニル) [1,2-ビス(ジフェニルホスフ ィノ) エタン] 鉄 (Il) 、シクロペンタジエニルヒド リドジカルボニル鉄(II)、プロモトリカルポニル (アリール) 鉄(II)、シクロペンタジエニル(メチ ル) ジカルボニル、二塩化 (2, 2'-ビピリジル) 鉄 (11)、二臭化(2,2'-ビピリジル)鉄(1 1) 、二沃化(2, 2'-ビピリジル)鉄(11)、ジ エチル (2, 2'ーピピリジル) 鉄(11) 等を挙げる ことができる。また、これらの二種以上の混合物及びビ ス (シクロベンタジエニル) 鉄 (1-11) テトラクロロ 鉄(111)酸塩のような複核錯体の使用も本発明の範 囲に含まれる。

(III) 等のハロゲン化物、硫酸コバルト(III)、硫酸コバルト(III)、磷酸コバルト(III)、烯酸コバルト(III)、過塩素酸コバルト(III)、硫化コバルト(III)等の無機塩、蓚酸コバルト(III)、酢酸コバルト(III)、丁マル酸コバルト(III)、乳酸コバルト(III)、グルコン酸コバルト(III)、クエン酸コバルト(III)、ケステリン酸コバルト(III)、カステアリン酸コバルト(III)、カステアリン酸コバルト(III)、カステアリン酸コバルト(III)、カステアリン酸コバルト(III)、アセチルアセトナート等の有機酸コバルト塩を挙げることができる。これらの水和物の使用も、本発明の範囲に含まれる。

【0014】また、一般式(2)

 $L_n C \circ X_n$ (2)

(式中、Lは、置換ホスフィン配位子、カルポニル配位 子又はアミン配位子を示し、各々同一であっても異なっ ても良く、置換ホスフィン配位子の場合、架橋されてい ても良い。nは配位数を示し0~6の整数である。Co は、零価、一価、二価又は三価である。又は、ハロゲン 原子、水素原子又は炭素数1~20の炭化水素基であ り、各々同一であっても異なっても良い。mはFeの価 数に相当する数を示す。) で示される有機コバルト錯 体、例えば、ヘキサカルボニルビス(トリーnープチル ホスフィン) ニコパルト(0)、塩化トリス(トリフェ ニルホスフィン)コパルト(I)、臭化トリス(トリフ ェニルホスフィン) コバルト(I)、沃化トリス(トリ フェニルホスフィン) コバルト (1) 、ヒドリドテトラ キス (ホスホン酸トリフェニル) コバルト (I)、ヒド リドテトラキス(ホスホン酸トリエチル)コパルト (1)、(シクロペンタジエニル)ビス(トリフェニル ホスフィン) コバルト (I) 、トリカルボニル (アリー ル)コバルト(I)、二塩化ピス(トリフェニルホスフ ィン) コバルト(II)、二臭化ビス(トリフェニルホ スフィン) コバルト (II) 、二沃化ピス (トリフェニ ルホスフィン) コバルト(11)、二塩化[1,2-ピ ス (ジフェニルホスフィノ) エタン] コバルト (I I)、二臭化[1,2-ピス(ジフェニルホスフィノ) エタン] コバルト (]])、二沃化 [1, 2-ビス (ジ フェニルホスフィノ) エタン] コバルト(11)、二塩 化[1,3-ビス(ジフェニルホスフィノ)プロパン] コパルト (I 1) 、二臭化 [1, 3 - ピス (ジフェニル ホスフィノ) プロパン] コパルト(I I)、二沃化 [1, 3-ビス(ジフェニルホスフィノ)プロパン]コ バルト (II)、二塩化ビス(トリーtープチルホスフ ィン) コバルト(I I)、二臭化ビス(トリーtーブチ ルホスフィン)コパルト(II)、二沃化ピス(トリー t-ブチルホスフィン)コパルト(II)、二塩化 [1.2-ビス(ジーt-ブチルホスフィノ)エタン] コパルト (11)、二臭化 [1, 2-ピス (ジーt-ブ チルホスフィノ) エタン] コバルト (I I) 、二沃化

[1, 2-ビス (ジーt-ブチルホスフィノ) エタン] コバルト(11)、二塩化[1,3-ビス(ジーt-ブ チルホスフィノ) プロパン] コパルト(11)、二臭化 [1, 3-ビス (ジ-t-ブチルホスフィノ) プロバ ン] コパルト (I I) 、二沃化 [1 , 3 ーピス (ジー t -ブチルホスフィノ) プロパン] コバルト (II)、二 塩化ピス(トリシクロヘキシルホスフィン)コパルト (11)、二臭化ピス(トリシクロヘキシルホスフィ ン) コバルト (11) 、二沃化ピス (トリシクロヘキシ ルホスフィン) コバルト(II)、二塩化ビス(トリエ チルホスフィン) コバルト (II) 、二臭化ビス (トリ エチルホスフィン)コバルト(II)、二沃化ピス(ト リエチルホスフィン) コバルト (II)、二塩化ビス (トリプロピルホスフィン) コパルト(11)、二臭化 ビス (ジエチルフェニルホスフィン) コバルト (1 1)、二臭化ピス(エチルジフェニルホスフィン)コバ ルト(II)、二臭化ピス(ジヘキシルホスフィン)コ バルト(II)、ジヒドリドビス[1,2-ビス(ジフ ェニルホスフィノ) エタン] コバルト(I I)、ジヒド リドビス [1, 2-ビス (ジ-t-ブチルホスフィノ) エタン] コバルト (11)、二塩化 (2, 2'ーピピリ ジル) コバルト (11)、二臭化 (2, 2'ーピピリジ ル) コバルト (I 1) 、二沃化 (2, 2'-ビビリジ ル) コパルト (ΙΙ)、ジエチル (2, 2 - ピピリジ ル) コバルト (11) トリス (アリール) コバルト (1 11)、沃化(シクロペンタジエニル)(シクロヘキサ ジエニル)コバルト(III)、二沃化(シクロペンタ ジエニル) (トリフェニルホスフィン) コパルト (II 1) 等を挙げることができる。また、これらの二種以上 の混合物及びビス (シクロペンタジエニル) コバルト (111) テトラクロロコバルト (111) 酸塩の如 き、複核錯体の使用も本発明の範囲に含まれる。 【0015】Ni(II)を有する化合物としては、具 体的には、弗化ニッケル(11)、塩化ニッケル(1 I)、臭化ニッケル(II)、沃化ニッケル(II)等 のハロゲン化物、硫酸ニッケル(II)、硝酸ニッケル (II)、過塩素酸ニッケル(II)、硫化ニッケル (II) 等の無機塩、ぎ酸ニッケル(II)、蓚酸ニッ ケル(II)、酢酸ニッケル(II)、フマル酸ニッケ ル (11)、乳酸ニッケル (11)、グルコン酸ニッケ ル(II)、安息香酸ニッケル(II)、ステアリン酸 ニッケル(11)、スルファミン酸ニッケル(11)、 アミド硫酸ニッケル(11)、炭酸ニッケル(11)、 ニッケル(11)アセチルアセトナート等の有機酸ニッ ケル塩を挙げることができる。これらの水和物の使用 も、本発明の範囲に含まれる。 【0016】また、一般式(3)

L_nNiX_n

(3)

(式中、しは、置換ホスフィン配位子、カルポニル配位

子又はアミン配位子を示し、各々同一であっても異なっ

ても良く、置換ホスフィン配位子の場合、架橋されてい ても良い。 n は配位数を示し0~6の整数である。N i は、零価、一価又は二価である。Xは、ハロゲン原子、 水素原子又は炭素数1~20の炭化水素基であり、各々・ 同一であっても異なっても良い。mはFeの価数に相当 する数を示す。) で示される有機ニッケル錯体、例え ば、トリカルボニル(トリフェニルホスフィンニッケル (0)、ジカルボニルピス(トリフェニルホスフィンニ ッケル (0)、テトラキス(トリフェニルホスフィン) ニッケル (0)、二窒素ビス [ビス(トリシクロヘキシ ルホスフィン) ニッケル(0)] 、(エチレン)ビス (トリフェニルホスフィン) ニッケル(0)、ビス(シ クロオクタジエン) ニッケル(0)、(シクロドデカト リエン)ニッケル(0)、塩化トリス(トリフェニルホ スフィン) ニッケル (1) 、臭化トリス (トリフェニル ホスフィン) ニッケル (1)、沃化トリス (トリフェニ ルホスフィン) ニッケル (1)、二塩化ビス (トリフェ ニルホスフィン)ニッケル(II)、二臭化ピス(トリ フェニルホスフィン)ニッケル(II)、二沃化ビス (トリフェニルホスフィン) ニッケル(II)、二塩化 20 [1, 2-ビス(ジフェニルホスフィノ)エタン]ニッ ケル(II)、二臭化[1,2-ピス(ジフェニルホス フィノ) エタン] ニッケル (II) 、二沃化 [1, 2-ビス (ジフェニルホスフィノ) エタン] ニッケル (I I)、二塩化[1,3-ピス(ジフェニルホスフィノ) プロパン] ニッケル (ΙΙ)、二臭化 [1, 3-ビス (ジフェニルホスフィノ) プロパン] ニッケル (I 1)、二沃化[1,3-ビス(ジフェニルホスフィノ) プロパン] ニッケル(II)、二塩化ピス(トリーt-ブチルホスフィン)ニッケル(II)、二臭化ビス(ト リーt-プチルホスフィン)ニッケル(II)、二沃化 ピス (トリー t - ブチルホスフィン) ニッケル(I I) 、二塩化 [1, 2-ビス(ジーt-ブチルホスフィ ノ) エタン] ニッケル (I I) 、二臭化 [1 , 2 - ピス (ジーt-ブチルホスフィノ) エタン] ニッケル (I I)、二沃化 [1. 2 - ピス(ジー t - ブチルホスフィ ノ) エタン] ニッケル(II)、二塩化 [1, 3-ビス (ジーt-ブチルホスフィノ) プロパン] ニッケル (I I)、二臭化[1,3-ビス(ジ-t-ブチルホスフィ ノ) プロパン] ニッケル(II)、二沃化 [1, 3-ピ 40 ス (ジー t ープチルホスフィノ) プロパン] ニッケル (II)、二塩化[1,2-ビス(ジシクロヘキシルホ スフィノ) エタン] ニッケル (11) 、二臭化 [1, 2 - ビス(ジシクロヘキシルホスフィノ)エタン]ニッケ ル (11)、二沃化[1,2-ビス(ジシクロヘキシル **ホスフィノ) エタン] ニッケル (II) 、二塩化 [1,** 3-ビス (ジシクロヘキシルホスフィノ) プロパン] ニ ッケル (11)、二臭化[1,3-ビス(ジシクロヘキ シルホスフィノ) プロパン] ニッケル(11)、二沃化 [1, 3-ビス(ジシクロヘキシルホスフィノ)プロパ 50

ン] ニッケル (11)、二塩化ビス (トリシクロヘキシ ルホスフィン)ニッケル(11)、二臭化ピス(トリシ クロヘキシルホスフィン) ニッケル (II) 、二沃化ビ ス (トリシクロヘキシルホスフィン) ニッケル (1 1)、二塩化ビス(トリメチルホスフィン)ニッケル (11)、二臭化ビス(トリメチルホスフィン)ニッケ ル(11)、二沃化ピス(トリメチルホスフィン)ニッ ケル(11)、二塩化ビス(トリエチルホスフィン)二 ッケル(11)、二臭化ピス(トリエチルホスフィン) ニッケル(II)、二沃化ピス(トリエチルホスフィ ン) ニッケル (II) 、二塩化ビス (トリiープロビル ホスフィン)ニッケル(II)、二臭化ビス(トリi-プロピルホスフィン)ニッケル(II)、二沃化ビス (トリi-プロピルホスフィン) ニッケル (II)、ニ 塩化ビス(トリn-ブチルホスフィン)ニッケル(I 1)、二臭化ビス(トリn-ブチルホスフィン)ニッケ ル(II)、二沃化ビス(トリn-ブチルホスフィン) ニッケル(II)、二塩化ビス(メチルジフェニルホス フィン)ニッケル(II)、二臭化ビス(メチルジフェ ニルホスフィン)ニッケル(II)、二沃化ピス(メチ ルジフェニルホスフィン)ニッケル(II)、二塩化ビ ス (ジメチルフェニルホスフィン) ニッケル (II) 、 二臭化ビス(ジメチルフェニルホスフィン)ニッケル (ІІ)、二沃化ビス(ジメチルフェニルホスフィン) ニッケル(II)、塩化(フェニル)ピス(トリフェニ ルホスフィン) ニッケル (I 1) 、臭化 (フェニル) ビ ス (トリフェニルホスフィン) ニッケル (11)、沃化 (フェニル)ビス(トリフェニルホスフィン)ニッケル (II)、ジメチルピス(トリメチルホスフィン)ニッ ケル (11)、テトラメチレンピス (トリフェニルホス フィン)ニッケル(II)、塩化(シクロペンタジエニ **ル)(トリフェニルホスフィン)ニッケル(II)、メ** チル(シクロペンタジエニル)(トリフェニルホスフィ ン) ニッケル (11)、塩化 (ヒドリド) ピス (トリシ クロヘキシルホスフィン)ニッケル(II)、二塩化 (2, 2'ーピピリジル) ニッケル (II)、二臭化・ (2, 2'-ピピリジル) ニッケル (11)、二沃化 (2, 2'-ビビリジル)ニッケル(11)、ジエチル (2, 2'-ビピリジル) ニッケル (11) 等を挙げる ことができる。また、これらの二種以上の混合物及び二 臭化ビス [2-(エトキシカルポニル)アリール]ニニ ッケル塩の如き、複核錯体の使用も本発明の範囲に含ま れる。

【0017】触媒成分である、金属ヒドリド構造をもたない 11B族有機金属化合物、111B族有機金属化合物としては、亜鉛、カドミウム、水銀、アルミニウム、ガリウム等の有機金属化合物が使用できる。これらのうち好ましくは有機亜鉛化合物、有機アルミニウム化合物である。

【0018】有機亜鉛化合物としては、例えば、下記一

般式(4)

 $R^{1} \circ Z \cap Y_{2-a} \tag{4}$

(式中、 R^1 は、アルキル基、アリール基、アルキルアリール基、アリールアルキル基、アルケニル基、アルキニル基等の炭素数 $1\sim 2$ 0の炭化水素基を示し、Yはハロゲンを示す。 aは、 $2 \ge a > 1$ なる数である。)及び下記一般式(5)

 $R^2 \times Z n M$ (5)

(式中、R²は、アルキル基、アリール基、アルキルア リール基、アリールアルキル基、アルケニル基、アルキ ニル基等の炭素数1~20の炭化水素基を示し、Mはリ チウム又はハロゲン化マグネシウムである。)で示され る有機亜鉛化合物を使用することができる。具体的に は、ジメチル亜鉛、ジエチル亜鉛、ジブチル亜鉛、ジフ ェニル亜鉛、塩化メチル亜鉛、臭化メチル亜鉛、沃化メ チル亜鉛、塩化エチル亜鉛、臭化エチル亜鉛、沃化エチ ル亜鉛、塩化n-プロピル亜鉛、臭化n-プロピル亜 鉛、沃化n-プロピル亜鉛、塩化i-プロピル亜鉛、臭 化iープロピル亜鉛、沃化iープロピル亜鉛、塩化nー ブチル亜鉛、臭化nープチル亜鉛、沃化nープチル亜 鉛、塩化i-ブチル亜鉛、臭化i-ブチル亜鉛、沃化i ブチル亜鉛、塩化secーブチル亜鉛、臭化secー ブチル亜鉛、沃化 s e c - ブチル亜鉛、塩化 t - ブチル 亜鉛、臭化 t ープチル亜鉛、沃化 t ープチル亜鉛、塩化 フェニル亜鉛、臭化フェニル亜鉛、沃化フェニル亜鉛、 トリメチル亜鉛リチウム、トリエチル亜鉛リチウム、ト リn-プロピル亜鉛リチウム、トリi-プロピル亜鉛リ チウム、トリn-ブチル亜鉛リチウム、トリi-ブチル 亜鉛リチウム、トリsec-プチル亜鉛リチウム、トリ t ープチル亜鉛リチウム、ジエチルn-ブチル亜鉛リチ ウム、トリメチル亜鉛マグネシウムクロリド、トリエチ ル亜鉛マグネシウムクロリド、トリn-プロピル亜鉛マ グネシウムクロリド、トリ i - プロピル亜鉛マグネシウ ムクロリド、トリn-ブチル亜鉛マグネシウムクロリ ド、トリiーブチル亜鉛マグネシウムクロリド、トリs e c - ブチル亜鉛マグネシウムクロリド、トリ t - ブチ ル亜鉛マグネシウムクロリド、ジエチルn-ブチル亜鉛 マグネシウムクロリド、トリメチル亜鉛マグネシウムブ ロミド、トリエチル亜鉛マグネシウムプロミド、トリn プロピル亜鉛マグネシウムブロミド、トリiープロピ ル亜鉛マグネシウムブロミド、トリn-ブチル亜鉛マグ ネシウムブロミド、トリi-ブチル亜鉛マグネシウムブ ロミド、トリsec-ブチル亜鉛マグネシウムブロミ ド、トリtープチル亜鉛マグネシウムプロミド、ジエチ ルn-ブチル亜鉛マグネシウムブロミド、エチル亜鉛ア イオダイド等を挙げることができる。

【0019】有機アルミニウム化合物としては、例えば、下記一般式(6)

 $R^{3}_{b}A 1 Z_{3-b}$ (6)

(式中、R³はアルキル基、アリール基、アルキルアリ

10

ール基、アリールアルキル基、アルケニル基、アルキニル基等の炭素数 $1 \sim 20$ の炭化水素基を示し、2 はハロゲン原子又はアルコキシ基を示す。b は、 $3 \ge b > 0$ なる数である。)又は下記一般式(7)

 R^4AIM (7)

(式中、R4は、アルキル基、アリール基、アルキルア リール基、アリールアルキル基、アルケニル基、アルキ ニル基等の炭素数1~20の炭化水素基を示し、Mはリ チウム又はハロゲン化マグネシウムである。)の有機ア ルミニウム化合物を使用することができる。具体的に は、トリメチルアルミニウム、トリエチルアルミニウ ム、トリイソプチルアルミニウム、メチルアルミニウム ジクロリド、メチルアルミニウムセスキクロリド、ジメ チルアルミニウムクロリド、エチルアルミニウムジクロ リド、エチルアルミニウムセスキクロリド、ジエチルア ルミニウムクロリド、イソプチルアルミニウムジクロリ ド、イソブチルアルミニウムセスキクロリド、ジイソブ チルアルミニウムクロリド、メチルアルミニウムジプロ ミド、メチルアルミニウムセスキプロミド、ジメチルア ルミニウムブロミド、エチルアルミニウムジブロミド、 エチルアルミニウムセスキプロミド、ジエチルアルミニ ウムブロミド、イソブチルアルミニウムジブロミド、イ ソブチルアルミニウムセスキブロミド、ジイソブチルア ルミニウムプロミド、ジエチルアルミニウムアイオダイ ド、メチルアルミニウムジエトキシド、メチルアルミニ ウムセスキエトキシド、ジメチルアルミニウムエトキシ ド、エチルアルミニウムジエトキシド、エチルアルミニ ウムセスキエトキシド、ジエチルアルミニウムエトキシ ド、イソブチルアルミニウムジエトキシド、イソブチル アルミニウムセスキエトキシド、ジイソプチルアルミニ ウムエトキシド、ジエチルアルミニウムメトキシド、テ トラメチルアルミニウムリチウム、テトラエチルアルミ ニウムリチウム、テトライソブチルアルミニウムリチウ ム、テトラフェニルアルミニウムリチウム、メチルトリ エチルアルミニウムリチウム、トリエチルカープチルア ルミニウムリチウム、トリエチル i - ブチルアルミニウ ムリチウム、トリエチル t - プチルアルミニウムリチウ ム、メチルトリi-ブチルアルミニウムリチウム、n-プチルトリ i ープチルアルミニウムリチウム、トリ i ー ブチル t - ブチルアルミニウムリチウム、トリメチルフ ェニルアルミニウムリチウム、トリエチルフェニルアル ミニウムリチウム、テトラメチルアルミニウムマグネシ ウムクロリド、テトラエチルアルミニウムマグネシウム クロリド、テトライソブチルアルミニウムマグネシウム クロリド、テトラフェニルアルミニウムマグネシウムク ロリド、メチルトリエチルアルミニウムマグネシウムク ロリド、トリエチルnープチルアルミニウムマグネシウ ムクロリド、トリエチルi-ブチルアルミニウムマグネ シウムクロリド、トリエチル t - プチルアルミニウムマ グネシウムクロリド、メチルトリュープチルアルミニウ

ムマグネシウムクロリド、n-ブチルトリi-ブチルア ルミニウムマグネシウムクロリド、トリ i ープチル t ー ブチルアルミニウムマグネシウムクロリド、トリメチル フェニルマグネシウムクロリド、トリエチルフェニルア ルミニウムマグネシウムクロリド、テドラメチルアルミ ニウムマグネシウムプロミド、テトラエチルアルミニウ ムマグネシウムブロミド、テトライソブチルアルミニウ ムマグネシウムブロミド、テトラフェニルアルミニウム マグネシウムブロミド、メチルトリエチルアルミニウム マグネシウムプロミド、トリエチルn-プチルアルミニ ウムマグネシウムブロミド、トリエチルi-ブチルアル ミニウムマグネシウムプロミド、トリエチル t - プチル アルミニウムマグネシウムプロミド、メチルトリューブ チルアルミニウムマグネシウムプロミド、n-ブチルト リューブチルアルミニウムマグネシウムブロミド、トリ i ープチル t ープチルアルミニウムマグネシウムプロミ ド、トリメチルフェニルマグネシウムブロミド、トリエ チルフェニルアルミニウムマグネシウムプロミド、メチ ルトリエチルアルミニウムマグネシウムアイオダイド等 を挙げることができる。これら周期律表 I I B族及び I I I B族有機金属化合物からなる群より選ばれるの二種 以上の混合物の使用も本発明の範囲に含まれる。

【0020】本発明においては触媒成分として更に電子 供与性化合物を使用することが好ましい。電子供与性化 合物としては、窒素原子、燐原子、酸素原子又は硫黄原 子を分子内に有する化合物が好ましく、これらのうちア ミン化合物、ホスフィン化合物が特に好ましい。具体的 には、N, N, N', N'-テトラメチルエチレンジア ミン、N, N, N', N'', N''-ペンタメチルジ エチレントリアミン、N, N'ージメチルピペラジン、 N. N-ジメチルアニリン、トリメチルアミン、トリエ チルアミン、トリーn-オクチルアミン、トリイソオク チルアミン、トリ (2-エチルヘキシル) アミン、トリ フェニルアミン、ピリジン、2,2'ーピピリジル、ト リフェニルホスフィン、トリーtープチルホスフィン、 1, 2-ビス (ジフェニルホスフィノ) エタン、1, 2 ーピス (ジーtープチルホスフィノ) エタン、1,3-ピス (ジーtープチルホスフィノ) プロパン、1,2-ピス (ジシクロヘキシルホスフィノ) エタン、1,3-ビス (ジシクロヘキシルホスフィノ) プロパン、トリシ クロヘキシルホスフィン、トリメチルホスフィン、トリ エチルホスフィン、トリーiープロビルホスフィン、ト リーnープチルホスフィンホスフィン、メチルジフェニ ルホスフィン、ジメチルフェニルホスフィンを挙げるこ とができる。これら電子供与性化合物の二種以上の混合 物の使用も本発明の範囲に含まれる。

【0021】本発明においてクロスカップリング反応は、下記一般式(8)、

Arli (8)

で示されるアリールリチウム化合物又は下記一般式

(9) (式中、Arはアリール基及び置換アリール基を 示す。)

ArMX (9)

(式中、Arはアリール基及び置換アリール基を示し、Mは、Mg、Zn、B、Al、Si ZはSnを示し、Xは、N口ゲン原子又はアルコキシ基を示す。)で示される有機金属化合物と、下記一般式(10)

RX (10)

(式中、Rは、ピニル基、アリール基又は置換アリール 基を示し、Xはハロゲン原子を示す。)で示されるハロ ゲン化炭化水素との間で行うことができる。

【0022】本発明においては、上記一般式(9)で示 される有機金属化合物のうち、MがMg又は2nである アリール金属化合物と、上記一般式(10)で示される ビニルハライド、アリールハライド又は置換アリールハ ライドとの間でクロスカップリング反応を行うことが特 に好ましい。MがMg又はZnであるアリール有機金属 化合物としては、具体的には、クロロベンゼン、ブロモ ベンゼン、ヨードベンゼン、2-ジクロロベンゼン、2 -ジプロモベンゼン、2-ジョードベンゼン、3-ジク ロロベンゼン、3-ジブロモベンゼン、3-ジヨードベ ンゼン、4-ジクロロベンゼン、4-ジブロモベンゼ ン、4-ジョードベンゼン、2-プロモクロロベンゼ ン、3-プロモクロロベンゼン、4-プロモクロロベン ゼン、2-ヨードクロロベンゼン、3-ヨードクロロベ ンゼン、4-ヨードクロロベンゼン、2-ヨードプロモ ベンゼン、3-ヨードプロモクロロベンゼン、4-ヨー ドブロモベンゼン、4-フルオロクロロベンゼン、4-フルオロブロモベンゼン、4-フルオロヨードベンゼ ン、4-トリルクロライド、4-トリルプロマイド、4 - トリルアイオダイド、2 - メトキシクロロベンゼン、 2-メトキシブロモベンゼン、2-メトキシヨードベン ゼン、3-メトキシクロロベンゼン、3-メトキシブロ モベンゼン、3-メトキシヨードベンゼン、4-メトキ シクロロベンゼン、4-メトキシブロモベンゼン、4-メトキシヨードベンゼン、2-t-ブトキシクロロベン ゼン、2-t-ブトキシブロモベンゼン、2-t-ブト キショードベンゼン、3-t-プトキシクロロベンゼ ン、3-t-ブトキシブロモベンゼン、3-t-ブトキ ショードペンゼン、4-t-ブトキシクロロペンゼン、 4-t-プトキシプロモベンゼン、4-t-プトキシヨ ードベンゼン、2-アセトキシクロロベンゼン、2-ア セトキシブロモベンゼン、2-アセトキシヨードベンゼ ン、3-アセトキシクロロベンゼン、3-アセトキシブ ロモベンゼン、3-アセトキシヨードベンゼン、4-ア セトキシクロロベンゼン、4~アセトキシブロモベンゼ ン、4-アセトキシヨードベンゼン、4-n-オクチル -2、3-ジフルオロフェニルクロライド、4-n-オ クチルー2、3ージフルオロフェニルプロマイド、4n-オクチル-2、3-ジフルオロフェニルアイオダイ

14

ド、4-n-ペンチルビフェニルクロライド、4-n-ペンチルビフェニルブロマイド、4-n-ペンチルビフ ェニルアイオダイド等を原料ハライドとする有機マグネ シウム化合物及び有機亜鉛化合物を挙げることができ る。これらの有機金属化合物とクロスカップリング反応 させるピニルハライド、アリールハライド又は置換アリ ールハライドとしては、ビニルクロライド、ビニルプロ マイド、ビニルアイオダイド、4-クロロペンゾニトリ ル、4-ブロモベンゾニトリル、4-ヨードベンゾニト リル、2-フルオロー4-クロロベンゾニトリル、2-フルオロー4ーブロモベンゾニトリル、2ーフルオロー 4-ヨードベンゾニトリル、3、4-ジフルオロクロロ ベンゼン、3,4-ジフルオロブロモベンゼン、3,4 -ジフルオロヨードベンゼン、3,3,4-トリフルオ ロクロロベンゼン、3,3,4-トリフルオロプロモベ ンゼン、3,3,4-トリフルオロフェニルヨードペン ゼン、4-トリフルオロメトキシクロロベンゼン、4-トリフルオロメトキシブロモベンゼン、4-トリフルオ ロメトキシヨードベンゼン、4-エトキシクロロベンゼ ン、4-エトキシブロモベンゼン、4-エトキシヨード 20 ベンゼン、2,3-ジフルオロ-4-エトキシクロロベ ンゼン、2,3-ジフルオロ-4-エトキシブロモベン ゼン、2、3-ジフルオロ-4-エトキシヨードベンゼ ン、4-(2-プテノキシ)クロロベンゼン、4-(2 ープテノキシ)プロモベンゼン、4-(2-プテノキ シ) ヨードベンゼン等を挙げることができ、更に、上記 の有機マグネシウム化合物及び有機亜鉛化合物有機金属 化合物の原料であるハライドを使用することもできる。

【0023】本発明においてクロスカップリング反応の反応条件は、特に限定されるものではないが、窒素、ア 30 ルゴン等の不活性ガス雰囲気下、有機反応及び錯体合成で一般的な溶媒、例えば、n-ペンタン、i-ペンタン、 $n-\wedge$ キサン、n-デカン、ベンゼン、トルエン、アセトン、ジエチルエーテル、ジイソプロピルエーテル、n-ブチルメチルエーテル、t-ブチルメチルエーテル、ジーn-ブチルエーテル、t-ブチルメチルエーテル、ジオキサン、N-メチルピロリドン、N, N-ジメチルホルムアミド、シメチルスルホキシド、トリエチルアミン、n+サメチルリン酸トリアミド等の溶媒中で、n+0~n

【0024】クロスカップリング反応の際に使用する触 媒量は、特に限定されるものではないが、上記一般式

- (8) で示されるアリールリチウム化合物又は一般式
- (9) で示される有機金属化合物 1.0molに対し、周期律表第四周期 VIII 族金属化合物が 0.0001 ~ 1.0mol となるような範囲で使用することが好ましく、特に好ましくは、0.001 ~ 0.1mol の範囲である。

【0025】また、触媒成分である周期律表 IIB族及 50

び111B族有機金属化合物の使用量は、周期律表第四周期V111族金属化合物1.0molに対し、0.01mol~100molとなるような範囲で使用することが好ましく、特に好ましくは、0.1mol~50molの範囲である。

【0026】また、電子供与性化合物は、周期律表第四周期V111族金属化合物1.0mo1に対し、0.01mo1~100mo1となるような範囲で使用することが好ましく、特に好ましくは、0.1mo1~50molの範囲である。

[0027] 触媒系の反応系への投入の条件は特に限定されないが、上記溶媒中で予め触媒成分を溶媒中で予め 混合し、投入する方法、上記三成分を反応系に別々に投入する方法等の如何なる投入形態をも使用できる。

【0028】以下に実施例を示すが、本発明は、これらの実施例によって何ら限定されるものではない。

[0029]

【実施例】実施例1

く有機マグネシウム化合物の合成>窒素雰囲気下、還流冷却器、滴下滤斗、攪拌装置を備えた1Lのフラスコに、マグネシウムの38.3g(1.58mol)とテトラヒドロフラン129.8g(1.80mol)を仕込み、攪拌開始後、これに滴下滤斗より、パラプロモクロロベンゼン287.2g(1.50mol)とエチルプロマイド8.20g(0.0753mol)をテトラヒドロフラン259.6g(3.60mol)で希釈して2時間攪拌し、p-クロロフェニルマグネシウムプロミドのテトラヒドロフラン溶液を得た。

【0030】 <クロスカップリング反応>このpークロロフェニルマグネシウムプロミドのテトラヒドロフラン溶液に、テトラヒドロフラン259.6g(3.60mol)を加え希釈し、塩化第二鉄(III)1.22g(7.52mmol)にトリエチルアルミニウムの0.94mol/Lのヘキサン溶液40.0ml(37.60mmol)を混合した触媒を加えた。室温で5分間攪拌の後、塩化ビニル93.8g(1.50mol)を積算流量計により、反応系が40℃以下となるように、氷浴により冷却しつつ、2時間で吹き込んだ。吹き込み終了後、室温にて更に1時間攪拌した。

【0031】反応終了後、反応液を塩化アンモニウム水溶液1」に加え反応を停止させた。この反応混合液にnーペキサン1」と加え、目的物であるpークロロスチレンを抽出した。得られたペキサン溶液を硫酸マグネシウムによる乾燥の後、生成したpークロロスチレン量をガスクロマトグラフィーによる内部標準法により定量したところ、pークロロスチレンは、129.5g(0.934mol)であり、これは、収率62.3%に相当した。結果を表1に示す。

[0032]

7	カロンセ…」よい、ガ	国知谷母第四国胡加林	国期待每 TR及1fmB柱	パラクロロスチレン
図の	人が シンプル 区内 おお 本	向都干效器四周数温版金属化合物	有機金属化合物	収率 (%)
ラヒド	テトラヒドロフラン	塩化第二鉄(田)	トリエチルアルミニウム	62.3
テトラヒドロフラン	びび	插化第二袋(日)	トリエチルアルミニウム	71.6
テトラヒドロフラン	ンテン	塩化第二鉄(田)	ı	25.8
テトラヒドロフラン	フラン	插化第二鉄(田)	トリエチルアルミニウム (ヘキサン洗浄除去)	19.9
テトラヒドロフラン	ガ	二塩化[1,3-ピス(ジフェニル ホスフィハブロパン]鉄(II)	トリイソブチル アルミニウム	59.0
テトラヒドロフラン	马	二塩化[1.3-ピス(ジフェニル ホスフィハ)プロパン]鉄(11)	•	11.6
テトラヒドロフラン	沙	二塩化[1,3-ピス(ジフェニル ホスフィノ)エタン]コパルト(II)	トリエチルアルミニウム	64.2
テトラヒドロフラン	ジだ	二塩化[1,3-ピス(ジフェニル ホスフィノ)エタン]コパルト(IL)	1	55.6
テトラヒドロフラン	フラン	二塩化[1.3-ピス(ジフェニル ホスフィノ)プロパン]ニッケル(エ)	トリイソブチルアルミニウム	79.9
テトラヒドロフラン	フラン	二塩化[1,3-ピス(ジフェニル ホスフィノ)エタン]ニッケル(II)	トリイソブチルアルミニウム	0.69
テトラヒドロフラン	ンラン	二塩化[1,3-ピス(ジフェニル ホスフィハ)プロ・ペン]ニッケル(エ)	1	9.6

[0033] 実施例2

実施例1のクロスカップリング反応において、pークロロフェニルマグネシウムブロミドのテトラヒドロフラン溶液の希釈溶媒をテトラヒドロフラン259.6g(3.60mol)に代えて、トルエン252.6g(2.74mol)としたこと以外は、実施例1と同様にpークロロスチレンの合成を行った。結果は、pークロロスチレン収率71.6%であった。結果を表1にあわせて示す。

【0034】比較例1

実施例1のクロスカップリング反応において、トリエチルアルミニウムの0.94mol/Lのヘキサン溶液40.0ml(37.60mmol)を触媒成分として添加せず、塩化第二鉄(111)1.22g(7.52mmol)のみを触媒成分とした以外は、実施例1と同様にp-クロロスチレンの合成を行った。結果は、p-クロロスチレン収率25.8%であり、更にポリ(p-クロロスチレン)が、p-クロロスチレンユニット換算で